# Масс-спектрометрическое исследование диффузии и растворимости гелия в палладии с субмикрокристаллической структурой

© А.Н. Жиганов,<sup>1</sup> А.Я. Купряжкин,<sup>1</sup> Р.Р. Мулюков,<sup>2</sup> И.Х. Биткулов<sup>2</sup>

 Уральский государственный технический университет — УПИ, 620062 Екатеринбург, Россия
 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, 450001 Уфа, Россия e-mail: kupr@dpt.ustu.ru

#### (Поступило в Редакцию 9 апреля 2002 г.)

Методом термодесорбции гелия из предварительно насыщенных в газовой фазе образцов палладия с субмикрокристаллической структурой измерены коэффициенты диффузии  $D_{\text{eff}}$  и растворимости  $C_{\text{eff}}$  гелия в интервале P = 0-3 MPa и T = 293-508 K. Зарегистрирован выход зависимости  $C_{\text{eff}}$  от давления на "плато" при повышении давления. Зависимости коэффициента диффузии и растворимости гелия от температуры при малых давлениях насыщения состоят из высокотемпературных 400–508 K (1) и низкотемпературных 293–400 K (2) участков, описываемых соответствующими экспонентами  $D_{1,2} = D_0 \exp(-E_{1,2}^D/kT)$ ,  $C_{1,2} = C_0 \exp(-E_{1,2}^P/kT)$  с энергиями активации диффузии  $E_2^D = 0.0036 \pm 0.0015$  eV на низкотемпературном участке и  $E_1^D = 0.33 \pm 0.03$  eV на высокотемпературном и энергиями растворения  $E_2^P = -0.025 \pm 0.008$  eV и  $E_1^P = 0.0086 \pm 0.008$  eV соответственно. Обсуждаются механизмы диффузии и растворения гелия.

### Введение

03:05:10:12

Исследование взаимодействия гелия с металлами обусловлено, как правило, проблемами гелиевого охрупчивания реакторных материалов (см., например, [1]), Большая часть работ такого рода посвящена изучению взаимодействия гелия с собственными и радиационными дефектами в металах и базируется на методике изучения процесса выделения гелия при линейном разогреве образцов, предварительно насыщенных гелием в процессе облучения нейтронами, α-частицами, или при насыщении тритием. Указанные методики, как правило, отвечают неравновесным условиям насыщения образцов гелием (концентрация гелия выше равновесной) и неравновесным (отжиг дефектов) условиям измерения, что в большинстве случаев не позволяет получить значения коэффициентов переноса гелия в металле, соответствующих конкретному механизму диффузии и растворимости.

Представляет интерес разработка дополнительных методик измерения для проведения исследований по получению коэффициентов диффузии и растворимости гелия в поликристаллах металлов. В настоящей работе такое исследование проведено при низких температурах на образцах палладия с субмикрокристаллической структурой, являющегося, в частности, одним из основных компонентов мембран, используемых для разделения изотопов водорода и отделения их от гелия. Самостоятельный интерес при этом представляет исследование характеристик металов с такой структурой.

## Экспериментальная установка и методика измерений

В настоящей работе для исследования диффузии и растворимости был выбран образец из палладия чистотой 99.99%, субмикрокристаллическая структура в котором получена с помощью больших пластических деформаций до истинной логарифмической степени e = 7 методом кручения под квазигидростатическим давлением на установке типа наковальни Бриджмена [2].

Исследования микроструктуры проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM 2000EX. Как следует из электронно-микроскопических исследований в результате интенсивной пластической деформации образцы приобретают сильнодиспергированную, насыщенную дислокациями структуру со средним размером зерен 150 nm. Плотность решеточных дислокаций ~  $3 \cdot 10^{10}$  cm<sup>-2</sup>. Образец имел форму пластинки толщиной  $h = (6.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-3}$  cm, общей геометрической площадью поверхности  $2S = 2.5 \pm \pm 0.1$  cm<sup>2</sup> и массой  $m = 90.9 \pm 0.1$  mg.

Экспериментальные исследования растворимости и диффузия гелия в палладии проводили методом термодесорбции гелия [3] из предварительно насыщенного при заданных температуре насыщения T и давлении насыщения P в гелиевой атмосфере образца (рис. 1). Методика эксперимента заключалась в следующем. Образец помещали в камеру насыщения (рис. 1, 9), которую откачивали до высокого вакуума (< 10<sup>-6</sup> Pa) при помощи диффузионного насоса с азотной ловушкой



Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — оптический манометр; 2 — калиброванный объем  $V_2$ ; 3 — калиброванный объем  $V_1$ ; 4 — измерительная камера; 5 — печи нагрева камер; 6 — масс-спектрометр МИ-1201Б; 7 — геттерный насос; 8 — пружинный манометр; 9 — камера насыщения; 10 — камера для подъема давления с сосудом Дьюара; 11 — баллон с газом; 12 — магнитоионизационный датчик давления (МИД); 13 — азотная ловушка; 14 — диффузионный насос; 15 — форвакуумный баллон; 16 — манометрический термопарный преобразователь (ПМТ-4М); 17 — форвакуумный насос.

(рис. 1, 13, 14), затем в камеру напускали гелий до давления P, контролируемого по манометру (рис. 1, 8) с погрешностью до 0.05 MPa, камеру нагревали печью (рис. 1, 5) до температуры T, которую поддерживали постоянной с погрешностью 0.1 К. В данной установке предусмотрена возможность насыщения образца при высоких давлениях, когда за счет охлаждения жидким азотом объема (рис. 1, 10) и его последующего нагрева до температуры, большей или равной комнатной, можно поднять давления в камере насыщения до 40 MPa при давлении гелия в баллоне (рис. 1, 11) ~ 10 MPa.

После выдержки образца в камере насыщения при данных условиях в течение времени, необходимого для насыщения, проводили закалку образца с гелием резким охлаждением до комнатной температуры и его перегрузку из камеры насыщения в измерительную камеру (рис. 1, 4). Время насыщения определяли экспериментально. После перегрузки образца измерительную камеру откачивали до высокого вакуума (<  $10^{-6}$  Pa), нагревали до той же температуры *T* и проводили измерения десорбции гелия из образца. Как показали проведенные расчеты, потери гелия из образца за время его закалки,

перегрузки и разогрева до рабочей температуры пренебрежимо малы.

Кинетику выделения гелия из образца регистрировали при помощи масс-спектрометра МИ-1201 Б, работающего в квазистатическом по гелию режиме откачки с регистрацией ионов на ВЭУ [4] при давлении в измерительной системе не хуже  $10^{-6}$  Ра. При измерении десорбции гелия из образца порции газа из измерительной камеры перепускали через равные промежутки времени для регистрации в объем масс-анализатора (рис. 1, 6), после чего проводили откачку измеренной порции газа. Измерение гелиевого фона в ячейке дегазации производили до и после десорбционного эксперимента.

Калибровку измерительной системы проводили методом двойного расширения известного количества газа, заключаемого в калиброванный объем  $V_1$  (рис. 1, 3), давление в котором измеряли при помощи оптического манометра с пределами шкалы 0–1 Torr (рис. 1, 1) [4].

Для обработки десорбционных кривых использовали решение второго уравнения Фика для образца в форме бесконечной пластины толщиной h для дегазации в вакуум (нулевые граничные условия) с эффективным коэффициентом диффузии  $D_{\rm eff}$  и эффективной растворимостью  $C_{\rm eff}$ . Обработку зависимости полного десорбционного потока гелия от времени дегазации t проводили по соотношению

$$J(t) = \frac{8SC_{\text{eff}}D_{\text{eff}}}{h} \sum_{k=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{\pi^2 (2k+1)^2 D_{\text{eff}}}{h^2} t\right).$$
 (1)

Для исключения влияния отжига при высокотемпературных экспериментах на результаты измерений производили контрольные повторные измерения при низких температурах. Коэффициент диффузии и растворимость определяли как при повышении температуры, так и при ее понижении.



**Рис. 2.** Характерные зависимости десорбционного потока гелия из образца от времени десорбции. 1 - T = 508 K, P = 25 MPa; 2 - T = 508 K, P = 2 MPa; 3 - T = 293 K, P = 25 MPa; 4 - T = 293 K, P = 2 MPa; 5 -аппроксимация.

На рис. 2 приведены характерные экспериментальные данные для предельных значений температур и давлений насыщения образца гелием. Во всем исследованном диапазоне давлений и температур зависимости логарифма потока от времени в пределах погрешности описываются прямыми линиями, что соответствует решению (1) при больших временах десорбции  $t > h^2/(\pi^2 D_{\text{eff}})$ , указывает на реализацию в эксперименте одного механизма переноса гелия с эффективными параметрами  $C_{\text{eff}}$ ,  $D_{\text{eff}}$  и позволяет определять коэффициент диффузии из угла наклона прямых  $\ln(J) = f(t)$ . Погрешность определения коэффициента  $D_{\text{eff}} \leq 7\%$ .

Растворимость гелия в палладии вычисляли по полной дегазации образца. Погрешность определения растворимости составила менее 10%.

### Экспериментальные результаты и их обсуждение

Характерные зависимости растворимости гелия в образцах палладия от давления насыщения для трех из семи полученных изотерм (для удобства представления результатов) приведены на рис. 3. Как следует из результатов измерений, при всех температурах зависимость  $C_{\text{eff}} = f(P)$  описывается кривыми с выходом на "плато", соответствующим соотношению типа [4]

$$C_{\rm eff}(P) = \frac{C^* \Gamma P}{1 + \Gamma P}, \qquad (2)$$

где  $C^*$  — концентрация насыщаемых позиций;  $\Gamma$  — величина, слабо зависящая от давления.

Значение  $C^* = (2.0 \pm 0.2) \cdot 10^{16} \, \mathrm{cm}^{-3}$  одинаково для всех исследованных температур. Повышение температуры приводит к уменьшению длины "плато" и сдвигу начала последующего после "плато" роста растворимости в область малых давлений насыщения.



**Рис. 3.** Зависимости растворимости гелия в образце от давления насыщения для различных температур насыщения. *T*, К: *1* — 387, *2* — 433, *3* — 508, *4* — аппроксимация.



**Рис. 4.** Температурная зависимость коэффициентов диффузии и растворимости при малом заполнении ловушек.  $1 - D_{\text{eff}}$  (P = 0.1-0.25 MPa);  $2 - C_{\text{eff}}$  (P = 0.1 MPa); 3 -аппроксимация.



**Рис. 5.** Зависимость коэффициентов диффузии гелия в образце от давления насыщения. *T*, K: *I* — 403, *2* — 433, *3* — аппроксимация.

На температурных зависимостях коэффициентов диффузии и растворимости гелия (рис. 4), соответствующих малым давлениям насыщения  $P = 10^3 - 10^5$  Ра (малым заполнением насыщаемых позиций), достоверно выделяются две температурные области: низкотемпературная (293–400 K) и высокотемпературная (400–508 K), в каждой из которых коэффициент диффузии  $D_{\rm eff}$  и растворимость  $C_{\rm eff}$  описываются экспоненциальными зависимостями

$$D_{\text{eff1,2}} = D_{\text{eff0}} \exp(-E_{1,2}^D/kT),$$
  

$$C_{\text{eff1,2}} = C_{\text{eff0}} \exp(-E_{1,2}^P/kT).$$
(3)

Соответствующие значения предэкспоненциальных множителей  $D_{\text{eff0}}$ ,  $C_{\text{eff0}}$  и энергий активации диффузии и растворимости  $E_{1,2}^P$ ,  $E_{1,2}^D$  приведены в таблице.

На рис. 5 приведены характерные кривые  $D_{\text{eff}} = f(P)$ для двух температур (T = 403 K, T = 433 K), на которых достоверно выделяются три характерных участка: участок малых давлений, где коэффициенты диффузии гелия в пределах погрешностей эксперимента не зависят

N₂	$\Delta T, K$	$D_{\rm eff0},{\rm cm}^2{\rm s}^{-1}$	$E^D$ , eV	$C_{\rm eff0},{\rm cm^{-3}}/(10^5{\rm Pa})$	$E^{P}$ , eV
1	293-400	$\left(0.98^{+1.1}_{-0.09}\right)\cdot10^{-9}$	$0.0036 \pm 0.0015$	$\left(0.7^{+0.31}_{-0.2}\right)\cdot10^{15}$	$-0.025 \pm 0.008$
2	400-508	$\left(1.1^{+0.9}_{-0.5} ight)\cdot10^{-5}$	$0.33\pm0.03$	$(1.5^{+0.41}_{-0.3})\cdot 10^{16}$	$0.086 \pm 0.008$

Значения параметров диффузии и растворимости гелия в границах зерен Pd с субмикрокристаллической структурой

от давления насыщения (степени заполнения насыщаемых позиций); переходный участок средних давлений, на котором  $D_{\rm eff}$  растет с ростом давления; участок "плато", где  $D_{\rm eff}$  вновь постоянно и не зависит от давления насыщения.

По данным исследований образцов палладия, полученных таким способом, а также методами электронпозитронной аннигиляции [5] и магнитной восприимчивости [6], последние имеют достаточно высокую по сравнению с обычным поликристаллом концентрацию вакансий и их скоплений (6–12 вакансий [5]). Отжиг образцов при температуре 473 К [6] приводит к увеличению размера зерен почти в два раза, причем концентрация скоплений вакансий по данным [5] уменьшается до пределов чувствительности метода после данной температуры, а концентрация вакансий, по данным [6] не должна изменяться до температуры ~ 823 К.

По результатам наших измерений значения  $D_{\rm eff}$ ,  $C_{\rm eff}$  не зависят от отжига образцов при температурах вплоть до 508 К и соответственно от размера зерна. При этом положение "плато" на зависимости  $C_{\rm eff} = f(P)$ , определяющее концентрации насыщаемых позиций, одинаково для всех температур. Следовательно, регистрируемый в эксперименте перенос атомов гелия является преимущественно зернограничным. Поскольку концентрация насыщаемых гелием позиций  $C^*$  (3) (рис. 3) не зависит от температуры, то такими позициями в образцах палладия с субмикрокристаллической структурой могут быть вакансии и вакансионные скопления на границе зерна, полученные в процессе деформации образца и не отжигающиеся при низких температурах.

При низких температурах заполняются дефекты с низкой энергией растворения. Такими дефектами в исследуемом образце могут являться оставшиеся неотожженными скопления вакансий, находящихся на границе зерна с энергией растворения гелия в них  $E_1^P = -0.025 \pm 0.008 \,\mathrm{eV}$ , сравнимой с энергией адсорбции гелия на поверхности твердых тел [7]. Гелий при этих же температурах диффундирует по границам зерен с энергией активации диффузии  $E_1^D =$  $= 0.0036 \pm 0.0015 \,\mathrm{eV}$ . При повышении температуры начинает преобладать растворимость гелия с энергией растворения  $E_2^P = 0.086 \pm 0.008 \, \text{eV}$  в более простых дефектах, в том числе и в вакансиях, энергии растворения в которых выше, но число которых больше. Диффузия при этом происходит еще и по этим дефектам с энергией активации диффузии  $E_2^D = 0.33 \pm 0.03$  eV.

Зарегистрированное повышение  $D_{\rm eff}$  с ростом давления насыщения может быть объяснено увеличением числа более подвижных комплексов Не–дивакансия или Не–Не, а также "сглаживанием" потенциального рельефа для диффундирующего в образце гелия за счет заполнения "ловушек" гелием.

Уточнение механизмов диффузии и растворимости гелия в поликристаллах и выяснение влияния вакансий и вакансионных скоплений на процессы переноса атомов гелия в поликристаллах требуют дополнительных исследований.

Мулюков Р.Р. и Биткулов И.Х. благодарны РФФИ (грант № 02-01-97924-р2002агидель а) и Комплексной программе РАН "Нанокристаллы и супрамолекулярные системы" за частичную финансовую поддержку.

#### Список литературы

- [1] Залужный А.Г., Суворов А.Л. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 2. С. 55–60.
- Mulyukov R.R., Starostenkov M.D. // Acta Met. Sinica. 2000.
   Vol. 13. N 1. P. 301–309.
- [3] Дудоров А.Г., Купряжкин А.Я. // ЖТФ. 1998. Т. 68. Вып. 12. С. 85–89.
- [4] Купряжкин А.Я., Куркин А.Ю. // ФТТ. 1993. Т. 35. Вып. 11. С. 3003–3007.
- [5] Würschum R., Kübler A. et al. // Ann. de Chim. Sci. des Mat. 1996. Vol. 21. P. 471–482.
- [6] Ремпель А.А., Гусев А.И. и др. // ДАН. 1995. Т. 345. № 3. С. 330–333.
- [7] Межфазовая граница газ-твердое тело / Под ред. Э. Флада.
   М.: Мир, 1970. 430 с.